УДК 621.315.592

А. Г. МИРОНОВ

плотность состоянии в обобщенной двухзонной модели

Экспериментальные данные по свойствам узкозонных полупроводников часто интерпретируются с помощью простых моделей энергетического спектра носителей заряда в актуальной области энергий — при значениях ее, отстоящих от краев зон на величины порядка ширины запрещенной зоны E_g или меньшие. Так, при анализе данных по термо-ЭДС в сильном магнитном поле в $Pb_{1-x}Sn_xTe$ [1] использовалисьизвестные модели Кейна и Коэна. Однако преимущества этих моделей, связанные с простотой аналитических выражений для законов дисперсии и энергетической зависимости плотности состояний по энергии, $\rho(E)$, в значительной мере обесцениваются необходимостью вводить для описания экспериментальных данных подгоночный параметр, так называемую «эффективную ширину запрещенной зоны».

В настоящей работе рассмотрена более общая модель спектра носителей заряда в узкозонном полупроводнике, являющаяся вариантом шестизонной модели Диммока [2] и полнее учитывающая влияние дальних энергетических зон. Основное дисперсионное уравнение для валентной зоны и зоны проводимости при этом имеет следующий вид:

$$(E - E_g/2 - \hbar^2 k_\perp^2/2m_t^- - \hbar^2 k_\parallel^2/2m_\parallel) \times \times (E + E_g/2 + \hbar^2 k_\perp^2/2m_t^+ + \hbar^2 k_\parallel^2/2m_\parallel) = P_\perp^2 k_\perp^2 + P_\parallel^2 k_\parallel^2.$$
(1)

Здесь за начало отсчета энергии принята середина запрещенной зоны, поперечная и продольная компоненты квазиволнового вектора k_ и k_{||} отсчитываются от какой-либо точки L в зоне Бриллюэна (для не слишком удаленных от краев зон энергий Е ограничимся независимым рассмотрением каждой из четырех пар экстремумов у точек L). Вклады в эффективные массы от дальних зон даются величинами, содержащими m_t^{\pm} и m_t^{\pm} (знак минус относится к электронам, плюс к дыркам); P_{\perp} и P_{\parallel} — междузонные матричные элементы соответственно поперечной и продольной компонент оператора импульса. Подобная модель была применена при определении параметров зонной структуры твердого раствора Pb_{1-x}Sn_xSe [3]. Однако ее использование затрудняется отсутствием соответствующих расчетов для плотности состояний и различных равновесных величин, связанных с ней, даже в сравнительно простом случае спектра, симметричного по отношению к электронам и дыркам. Этот случай имеет место, например, для материалов $Pb_{1-x}Sn_xTe$ и $Pb_{1-x}Sn_xSe$ при $x \leq 0,2$. При этом $m_1 = m_1^+ = m_1^+$ и $m_{\parallel} = m_{\parallel}^+ = m_{\parallel}$. Обозначим через m_t и m_l соответственно поперечную и продольную эффективные массы вблизи краев зон:

$$m_{i}^{-1} = m_{\perp}^{-1} + 2P_{\perp}^{2}/\hbar^{2}E_{g}, \quad m_{i}^{-1} = m_{\parallel}^{-1} + 2P_{\parallel}^{2}/\hbar^{2}E_{g}.$$
 (2)

്ദ

Введем параметры a_{\perp} и a_{\parallel} , дающие относительные вклады влияния дальних зон в величины m_t^{-1} и m_t^{-1} :

$$a_{\perp} = m_t / m_{\perp}, \quad a_{\parallel} = m_t / m_{\parallel}. \tag{3}$$

Вычислим теперь плотность и число состояний в зоне (ввиду симметрии спектра ограничимся лишь зоной проводимости) как функции энергии *E* и этих параметров.

Для плотности состояний по энергии с учетом двукратного вырождения и наличия М=4 пар экстремумов мы имеем

$$\rho(E) = \frac{M}{2\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} dk_{\parallel} \int_{0}^{\infty} k_{\perp} dk_{\perp} \,\delta(E - E(k_{\parallel}, k_{\perp})). \tag{4}$$

Введем также величину N(E) — число состояний в зоне с энергиями не больше E:

$$N(E) = \int_{E_{g}/2}^{E} dE' \rho(E').$$
 (5)

Введем безразмерные энергию, ε , и квазиволновой вектор с компонентами q_{\perp} и q_{\parallel} :

$$\varepsilon = E/E_g, \ q_{\perp} = \hbar k_{\perp} / \sqrt{2m_t E_g}, \ q_{\parallel} = \hbar k_{\parallel} / \sqrt{2m_t E_g}.$$
(6)

Тогда дисперсионное уравнение (1) для симметричного спектра можно записать в виде

$$\varepsilon^{2} - \left(\frac{1}{2} + \alpha_{\parallel} q_{\parallel}^{2} + \alpha_{\perp} q_{\perp}^{2}\right)^{2} = (1 - \alpha_{\parallel}) q_{\parallel}^{2} + (1 - \alpha_{\perp}) q_{\perp}^{2}.$$
(7)

Переходя с помощью (6) и (3) к безразмерным переменным в формулах (4) и (5), мы получаем

$$\rho(E) = \int_{-\infty}^{\infty} dq_{\parallel} \int_{0}^{\infty} q_{\perp} dq_{\perp} \delta(\varepsilon - \varepsilon_{\perp} (q_{\parallel}, q_{\perp})) = E_{g}^{-1} \frac{dN(E)}{d\varepsilon}, \qquad (8)$$

$$N(E) = AE_{g} \int_{-\infty}^{\infty} dq_{\parallel} \int_{0}^{\infty} q_{\perp} dq_{\perp} \Theta(\varepsilon - \varepsilon_{-}(q_{\parallel}, q_{\perp})), \qquad (9)$$

где Θ — обычная ступенчатая функция, $A = Mm_t \sqrt{2m_l E_p} / \pi^2 \hbar^3$,

$$\varepsilon_{-} (q_{\parallel}, q_{\perp}) = \left[\left(\frac{1}{2} - \alpha_{\parallel} q_{\parallel}^{2} + \alpha_{\perp} q_{\perp}^{2} \right)^{2} + (1 - \alpha_{\parallel}) q_{\parallel}^{2} + (1 - \alpha_{\perp}) q_{\perp}^{2} \right]^{1/2}.$$
(10)

Интегрирование по q_1 в (9) дает

$$N(E) = \frac{AE_g}{2a_{\perp}^2} \int_{0}^{q_{\parallel}\max} dq_{\parallel} \left[\sqrt{t + 4a_{\perp}q_{\parallel}^2 (a_{\parallel} - a_{\perp})} - 1 - 2a_{\perp}a_{\parallel} q_{\parallel}^2 \right], \quad (11)$$

где

$$q_{\parallel \max}^{2} = \left(\sqrt{1 + \alpha_{\parallel}^{2} g^{2}} - 1\right) / 2\alpha_{\parallel}^{2}, \qquad (12)$$

$$g^{2} = g^{2}(\varepsilon) = 4\varepsilon^{2} - 1, \quad t = t(\varepsilon) = 1 + \alpha_{\perp}^{2} g^{2}(\varepsilon). \quad (13)$$

() (**14** Дифференцированием по є отсюда нетрудно получить

$$\rho(E) = 2A \varepsilon \int_{0}^{q_{\parallel} \max} dq_{\parallel} [t + 4\alpha_{\perp} q_{\parallel}^{2} (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp})]^{-1/2}.$$
(14)

Введем обозначение

$$\gamma^{2} = 2\alpha_{\perp} |\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}| \left(\sqrt{1 + \alpha_{\parallel}^{2} g^{2}} - 1 \right) / t \alpha_{\parallel}^{2}.$$
 (15)

Интегрирование по q_{\parallel} в формулах (11), (14) дает для $\alpha_{\parallel} > \alpha_{\perp}$:

$$V(E) = AE_g \{t \left[\gamma \sqrt{1+\gamma^2} + \ln \left(\gamma + \sqrt{1+\gamma^2}\right)\right] - 2\gamma \sqrt{t} - \frac{\gamma^3 t^{3/2} \alpha_{\parallel} / 3 (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp})}{\left[8\alpha_{\perp}^2 \sqrt{\alpha_{\perp} (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp})}\right]^{-1}},$$
(16)

$$\varphi(E) = A \varepsilon \ln \left(\gamma + \sqrt{1 + \gamma^2} \right) \left[\alpha_{\perp} \left(\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp} \right) \right]^{-1/2}.$$
(17)

В случае $a_1 < a_1$ мы находим

$$N(E) = A E_g \{ t (\arcsin \gamma + \gamma \sqrt{1 - \gamma^2}) - 2\gamma \sqrt{t} - -\alpha_{\parallel} \gamma^3 t^{3/2} / 3 (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\parallel}) \} [8\alpha^2 \sqrt{\alpha_{\parallel} (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\parallel})}]^{-1},$$
(18)

$$\rho(E) = A \varepsilon \arcsin \gamma \cdot [\alpha_{\perp} (\alpha_{\perp} - \alpha_{\parallel})]^{-1/2}.$$
(19)

Наконец, в частном случае равного относительного влияния дальних зон на поперечную и продольную эффективные массы, т. е. при $\alpha_{\parallel} = -\alpha_{\perp} = \alpha$, мы имеем

$$N(E) = \frac{aE_g}{3\sqrt{2} a^3} \left(\sqrt{1 + a^2 g^2} - 1\right)^{3/2},$$
 (20)

$$\rho(E) = \frac{A\varepsilon \sqrt{2}}{\alpha \sqrt{1+\alpha^2 g^2}} \left(\sqrt{1+\alpha^2 g^2} - 1\right)^{1/2}.$$
 (21)

Интересно сравнить полученные результаты для $\rho(E)$ и N(E) с результатами частного случая $\alpha_{\parallel} = \alpha_{\perp} = 0$, отвечающего модели Кейна. В последнем случае мы имеем

$$N_0(E) = \frac{2}{3} A E_g (\epsilon^2 - 1/4)^{3/2}, \qquad (22)$$

$$\rho_0(E) = 2A \varepsilon (\varepsilon^2 - 1/4)^{1/2}.$$
(23)

Обозначим через f_N отношение $N(E)/N_0(E)$, а через f_ρ отношение $\rho(E)/\rho_0(E)$. Тогда для энергии $E = E_g/2 + 1,08 E_g$ (отвечающей значению g(e) = 3) и при $\alpha_\perp = 0,6$, $\alpha_\parallel = 0,5$ мы имеем $f_\rho = 0,42$, а при $E = 2,06 E_g - f_\rho = 0,31$. Заметно и влияние дальних зон на число состояний; так, при $\alpha_\perp = \alpha_\parallel = 0,50$ мы имеем $f_N = 0,50$ для $E = 1,5 E_g$ и $f_N = 0,41$ для $E = 2 E_g$. Поведение относительного отклонения плотности состояний от результата модели Кейна как функции энергии характеризуют следующие частные значения $f_\rho(E)$ для случая $\alpha_\perp = 0,6$; $\alpha_\parallel = 0,3$: $f_\rho(0,71) = 0,87$; $f_\rho(1,03) = 0,69$; $f_\rho(1,56) = 0,36$; $f_\rho(2,45) = 0,30$.

Полученные аналитические результаты для N(E) позволяют также оценить влияние дальних зон и на концентрацию, *n*, электронов в зоне проводимости. Аналогично предыдущему относительное изменение *n* по сравнению с результатом для модели Кейна обозначим через f_n . Возьмем для примера два значения величины $v = E_g/kT$: $v_1 = 8,36$ и $v_2 = = 18,4$, отвечающие материалу Pb_{0.8}Sn_{0.2}Te при T = 300 и 80 K соответ-

ственно. Тогда, интегрируя произведение N(E) с производной от фермиевского распределения по методу квадратур Гаусса [4], мы находим, что, например, для $\alpha = 0.5$, $v = v_1$ и при значении уровня Ферми $\mu = \mu_1 = -4 kT$ $f_n = 0.864$, а при $\mu = \mu_2 = -kT$ имеем $f_n = 0.857$; для $\alpha = -0.5$ и $v = v_2$ мы имеем $f_n(\mu_1) = 0.942$, $f_n(\mu_2) = 0.939$. Таким образом, отклонения спектра от модели Кейна менее существенно сказываются на величине рассчитываемой концентрации носителей заряда, хотя такие отклонения, несомненно, важны в случае вырожденного газа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Равич Ю. И., Ефимова Б. А., Смирнов И. А. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца. М., 1968, 383 с. 2. D immock J. O. k-p theory for the conduction and valence bands of Pb_{1-x}Sn_xTe and Pb_{1-x}Sn_xSe alloys.— J. Phys. Chem. Solids Suppl., 1971, 32, p. 319—330. 3. Кучеренко И. В., Монсеенко В. Н., Шотов А. П. Определение параметров зонной структуры полупроводников Pb_{1-x}Sn_xSe из измерений эффекта Шубникова-де-Гааза.— Физ. и техн. полупроводников, 1977, 11, № 1, с. 162—167. 4. Грязнов О. С. Вычисление кинетических коэффициентов для полупроводников.— Л., 1977, 167 с.

Поступила в редакцию 13.06.78

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. З. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1981. т. 22. № 1

УДК 539.17.01

н. ф. нелипа, А. е. пухов

СРЕДНЯЯ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ЧАСТИЦ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯДЕР С ЯДРАМИ, В МОДЕЛИ НЕЗАВИСИМЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ

Введение. В последние годы разработан ряд моделей [1-3], успешно описывающих различные характеристики адрон-ядерных взаимодействий. Одной из них является модель независимых соударений [2, 3], которая хорошо описывает инклюзивные спектры частиц, рождающихся при столкновении адрона с энергией E > 100 ГэВ с ядром. Эта модель может быть обоснована в рамках реджионного подхода.

В настоящей работе модель независимых соударений обобщается на случай взаимодействия ядер с ядрами. В § 1 изложены основные положения модели независимых соударений. В § 2 получена формула, выражающая N_{AB} — среднюю множественность частиц, рожденных при столкновении ядер A и B, через N(s) — среднюю множественность нуклон-нуклонных взаимодействий. В § 3 при различных предположениях о поведении N(s) получены формулы, выражающие N_{AB} через N_{pA} и N_{pB} — средние множественности в нуклон-ядерных реакциях. И наконец, в § 4 произведено сравнение теоретических и экспериментальных значений средней множественности.

§ 1. Модель независимых столкновений. Модель независимых столкновений основана на том, что продольное расстояние, на котором происходит взаимодействие адронов, растет с ростом энергии. При достаточно больших энергиях это расстояние становится сравнимым с размером ядра, и налетающий на ядро адрон взаимодействует практи-